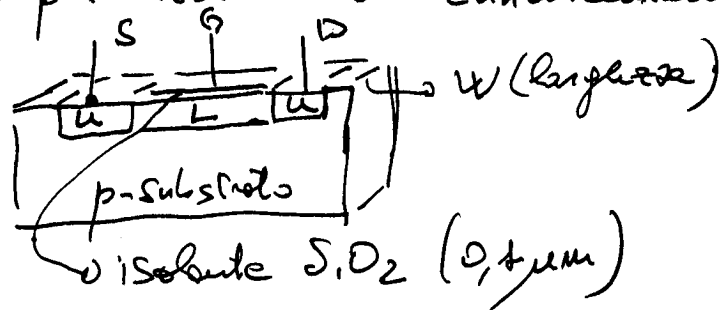


Complementi su FET e MOS

1

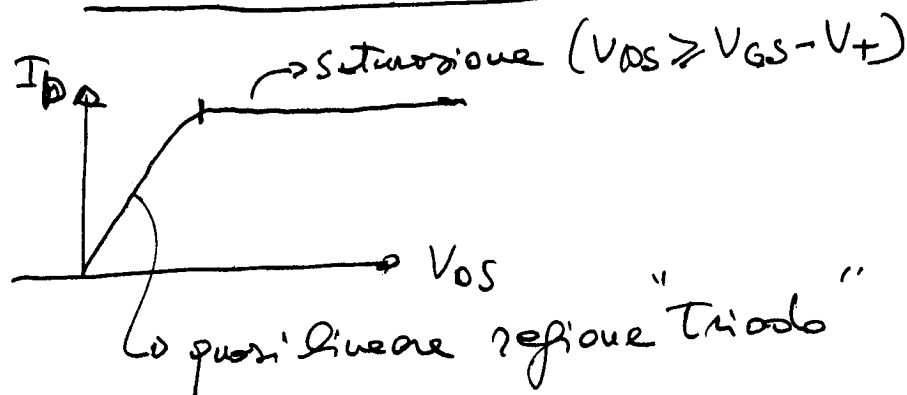
- può usarsi $\Rightarrow$ enhancement MOSFET



p-substrato $\Rightarrow$ a p-nazione $\Rightarrow$ evita conduzione nel canale
substrato a n $L \approx 1 \div 10 \mu\text{m}$ e $w = 2 \div 500 \mu\text{m}$

$V_{GS} > V_T$ per inizio conduzione nell'enhancement
 $\downarrow$

$V_{GS} - V_T = \text{eccesso voltaggio di gate}$



p-channel $\rightarrow$ viceversa su substrato "n"

In regione "Triodo" I_D verso V_{DS} è descritto da:

$$i_D = k \left[2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2 \right]$$